

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11) 特許出願公開番号

特開2004-137480
(P2004-137480A)

(43) 公開日 平成16年5月13日(2004.5.13)

(51) Int. Cl. ⁷	F I	テーマコード (参考)
C09K 11/78	C09K 11/78 CPB	3K007
C09K 11/78	C09K 11/78 CPD	4H001
C09K 11/00	C09K 11/00 F	4K029
C09K 11/08	C09K 11/08 A	
C09K 11/84	C09K 11/08 B	

審査請求 未請求 請求項の数 7 O L (全 17 頁) 最終頁に続く

(21) 出願番号	特願2003-326736 (P2003-326736)	(71) 出願人	000003067 TDK株式会社 東京都中央区日本橋1丁目13番1号
(22) 出願日	平成15年9月18日 (2003.9.18)	(71) 出願人	500174030 三浦 登 東京都文京区西片1-8-18
(31) 優先権主張番号	特願2002-274516 (P2002-274516)	(74) 代理人	100088155 弁理士 長谷川 芳樹
(32) 優先日	平成14年9月20日 (2002.9.20)	(74) 代理人	100092657 弁理士 寺崎 史朗
(33) 優先権主張国	日本国 (JP)	(74) 代理人	100108213 弁理士 阿部 豊隆
		(72) 発明者	三浦 登 東京都文京区西片一丁目8-18

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 蛍光体薄膜およびその製造方法ならびにELパネル

(57) 【要約】 (修正有)

【課題】 高輝度な蛍光体薄膜およびその製造方法ならびにこれを用いたELパネルを提供する。

【解決手段】 蛍光体薄膜は、組成式 $A_x B_y O_w S_z$ で表される母材を有し、この母材に対し発光中心として機能する物質が含有されている。(上記組成式中のAはMg、Ca、Sr、BaおよびZnからなる群から選ばれた少なくとも一つの元素、BはSc、Y、La、Ce、Pr、Nd、Pm、Sm、Eu、Gd、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Yb及びLuからなる群から選ばれた少なくとも一つの元素、Oは酸素原子、Sは硫黄原子をそれぞれ意味する。また、 $0 < x < 5$ 、 $0 < y < 4$ 、 $0 < z < 8$ 、 $0 < w < 8$ であり、 $0 = z = w$ となることはない。) 該蛍光体薄膜は、前記の元素の硫化物又は酸化物と、発光中心として機能する物質から蒸着法により薄膜を形成し、アニール処理して製造され、ELパネルに用いられる。

【選択図】 なし

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

下記組成式で表される母材を有し、



[但し、AはMg、Ca、Sr、BaおよびZnからなる群から選ばれた少なくとも一つの元素、BはSc、Y、La、Ce、Pr、Nd、Pm、Sm、Eu、Gd、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Yb及びLuからなる群から選ばれた少なくとも一つの元素を表し、 $0 < x < 5$ 、 $0 < y < 4$ 、 $0 < z < 8$ 、 $0 < w < 8$ であり、 $0 = z = w$ となることはない。]

この母材に対し発光中心として機能する物質が含有されている蛍光体薄膜。

10

【請求項 2】

前記発光中心として機能する物質が、MnまたはMn化合物である請求項 1 の蛍光体薄膜。

【請求項 3】

前記発光中心として機能する物質が、EuまたはEu化合物である請求項 1 の蛍光体薄膜。

【請求項 4】

前記発光中心として機能する物質が、CeまたはCe化合物である請求項 1 の蛍光体薄膜。

【請求項 5】

前記母材は $0.001 < w / (z + w) < 0.6$ を満たす、請求項 1 ~ 4 の何れか一項に記載の蛍光体薄膜。

20

【請求項 6】

請求項 1 ~ 5 の何れかの蛍光体薄膜を有するELパネル。

【請求項 7】

蒸発源として、Mg、Ca、Sr、BaおよびZnからなる群から選ばれた少なくとも一つの元素と、Sc、Y、La、Ce、Pr、Nd、Pm、Sm、Eu、Gd、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Yb及びLuからなる群から選ばれた少なくとも一つの元素の硫化物または酸化物と、発光中心として機能する物質と、が添加されている単一蒸発源を用い蒸着法により薄膜を形成する工程と、形成された薄膜にアニール処理を施す工程と、を有する蛍光体薄膜の製造方法。

30

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

本発明は、蛍光体薄膜およびその製造方法ならびにELパネルに関する。

【背景技術】

【0002】

近年、小型または、大型軽量のフラットパネルディスプレイ用の発光素子として、薄膜ELパネルが盛んに研究されている。黄橙色発光のマンガン添加硫化亜鉛からなる蛍光体薄膜を有するELパネルとして、薄膜の絶縁層を用いた2重絶縁型構造のELパネルが知られており、このようなELパネルを用いたモノクロ薄膜ELディスプレイが実用化されている。

40

【0003】

具体的には、このELパネルは、基板上に、所定のパターンの下部電極が形成されていて、この下部電極が形成されている基板上に第1の絶縁層が形成されている。また、この第1の絶縁層上には、蛍光体薄膜、第2の絶縁層が順次形成されるとともに、第2の絶縁層上に上記下部電極とマトリクス回路を構成するように上部電極が所定のパターンで形成されている。蛍光体薄膜の輝度向上のため、ガラス基板の歪み点以下で蛍光体薄膜のアニールを行うのが普通である。

【0004】

50

また、最近では、基板にセラミックス基板を用い、絶縁層に厚膜誘電体層を用いた構造のELパネルが提案されている。さらに、基板に高誘電率のBaTiO₃薄板を用い、基板の裏側に電極を形成し、薄板を絶縁層兼基板として用いる構造も提案されている。これらの構造では、基板として、アルミナ、BaTiO₃などのセラミックスを用いているため、蛍光体薄膜の高温アニールが可能で高輝度化が可能である。また、絶縁層に厚膜または薄板誘電体層を用いているため、絶縁層に薄膜を用いたELパネルに較べて、絶縁破壊に強く、信頼性に強いことが特徴である。ここで、2重絶縁型構造のように蛍光体薄膜を絶縁層でサンドイッチにする構造は必ずしも必要ではない。絶縁層は、厚膜または薄板誘電体層の何れかが片側のみにあれば良い。

【0005】

10

このようなELパネルを用いたディスプレイをパソコン用、TV用、その他表示用のカラーディスプレイに対応させるためにはELパネルのカラー化が必要不可欠である。

【0006】

赤色、緑色、青色の3原色に発光するELパネル用の蛍光体薄膜として、硫化物蛍光体薄膜等が知られている。硫化物蛍光体薄膜を用いた薄膜ELパネルは、信頼性、耐環境性に優れている。硫化物蛍光体薄膜を例示すると、青色発光蛍光体としては、母材(母体材料)としてSrS、発光中心としてCeを用いたSrS:CeやZnS:Tm、赤色発光蛍光体としてはZnS:Sm、CaS:Eu、緑色発光蛍光体としてはZnS:Tb、CaS:Ceなどが知られており研究が続けられている。

【発明の開示】

20

【発明が解決しようとする課題】

【0007】

しかしながら、これら赤色、緑色、青色に発光する蛍光体薄膜は、発光輝度が十分でなく、現在、ELパネルを用いたカラーディスプレイは実用化には至っていない。

【0008】

具体的には、例えば、赤色用の蛍光体薄膜として、CaS:Euを用いた蛍光体薄膜が知られており、比較的色純度の良い発光が得られている。そして、この蛍光体薄膜はさらに特開平1-206594号公報、特開平2-148688号公報などによって改良されている。しかしながら、この蛍光体薄膜は、フルカラーディスプレイ用の赤色としては、輝度、効率などの発光特性が不足している。なお、特開平2-51891号公報、テレビジョン学会技術報告Vol.16、No.76、p7-11に述べられているように、この蛍光体薄膜は、応答時間として、数秒から数十秒を要するという問題もあり、駆動信号に対してリアルタイムで応答することが要求される動画表示のフルカラーディスプレイ用の赤色のELパネルとしてはそのままでは、実用になりにくい。

30

【0009】

一方、輝度と効率の高いオレンジ色の蛍光体薄膜であるZnS:Mn膜から発光させたELスペクトルから、カラーフィルタを用いて赤色の波長帯域を切り出して赤色光を得る方法も試みられている。しかし、フィルタを備えるELディスプレイの製造工程は複雑であり、さらに最も問題なのはフィルタによって輝度が低下してしまうことである。具体的には、フィルタを用いて赤色光を取り出すことにより、輝度が10~20%低下してしまう。従って、輝度が不十分となり実用になりにくい。

40

【0010】

また、近年では、各色発光用の蛍光体薄膜として、希土類添加アルカリ土類チオガレート蛍光体[MGa₂S₄:RE{Mはアルカリ土類元素、REはセリウム(Ce)}]の開発(特開平5-65478号参照)や希土類添加アルカリ土類チオアルミネート蛍光体[MA₂S₄:RE{Mはアルカリ土類元素、REはセリウム(Ce)およびユーロピウム(Eu)}]の開発(特許第2840185号)が報告されているが、実用上十分な輝度が得られていない。

【0011】

本発明は上記課題に鑑みてなされたものであり、高輝度な蛍光体薄膜およびその製造方

50

法ならびにこれを用いた E L パネルを提供することを目的とする。

【課題を解決するための手段】

【0012】

発明者らは、鋭意研究を重ねた結果、ユーロピウム添加硫化カルシウム ($\text{CaS} : \text{Eu}$) にイットリウムを加えた複合化合物 (例えば、チオイトレート化合物、 $\text{CaY}_2\text{S}_4 : \text{Eu}$) を用いた新組成の蛍光体薄膜から放射される光の輝度が、従来に比して飛躍的に高くなることを見だし、本発明に想到するに至った。

【0013】

本発明に係る蛍光体薄膜は、組成式 $A_x B_y O_w S_z$ で表される母材を有し、この母材に対し発光中心として機能する物質が含有されている。ここで、上記組成式中の A は Mg、Ca、Sr、Ba および Zn からなる群から選ばれた少なくとも一つの元素、B は Sc、Y、La、Ce、Pr、Nd、Pm、Sm、Eu、Gd、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Yb 及び Lu からなる群から選ばれた少なくとも一つの希土類元素、O は酸素原子、S は硫黄原子をそれぞれ意味する。また、 $0 < x < 5$ 、 $0 < y < 4$ 、 $0 < z < 8$ 、 $0 < w < 8$ であり、 $0 = z = w$ となることはない。

【0014】

このような蛍光体薄膜の発光輝度は、従来に比して十分に高くなる。なお、このような蛍光体薄膜から放射される光の波長は、成分 A、成分 B、および発光中心として機能する物質 M の組合せに応じて様々である。

【0015】

ここで、発光中心として好適に機能する物質としては、例えば、Mn または Mn 化合物、Eu または Eu 化合物、Ce または Ce 化合物が挙げられる。

【0016】

また、母材は $0.001 < z / (z + w) < 0.6$ を満たすことが好ましく、これにより蛍光体薄膜の寿命が延びる。

【0017】

本発明に係る蛍光体薄膜の製造方法は、蒸発源として、Mg、Ca、Sr、Ba および Zn からなる群から選ばれた少なくとも一つの元素と、Sc、Y、La、Ce、Pr、Nd、Pm、Sm、Eu、Gd、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Yb 及び Lu からなる群から選ばれた少なくとも一つの元素の硫化物または酸化物と、発光中心として機能する物質と、を含む単一蒸発源を用いて蒸着法により薄膜を形成する工程と、形成された薄膜にアニール処理を施す工程と、を有する。

【0018】

このような方法によれば、複数蒸発源を用いる際に必要な各蒸発源個々の制御をすることなく、上述の蛍光体薄膜を容易に製造できる。

【0019】

また、本発明に係る E L パネルは、上述の蛍光体薄膜を有する。

【発明の効果】

【0020】

本発明によれば、高輝度に発光する E L パネルを提供できるので、高性能な E L カラーディスプレイを実現できる。

【発明を実施するための最良の形態】

【0021】

以下、本発明の実施形態について詳細に説明する。

【0022】

本実施形態の蛍光体薄膜は、組成式 $A_x B_y O_w S_z : M$ で表される蛍光体薄膜である。すなわち、この蛍光体薄膜は、組成式 $A_x B_y O_w S_z$ で示される母材に、発光中心として機能する物質 M が添加されている。

【0023】

ここで、元素 A は、アルカリ土類元素であるマグネシウム、カルシウム、ストロンチウ

10

20

30

40

50

ム、バリウム、あるいは亜鉛のいずれか1種類または2種類以上の組合せである。元素Bは、スカンジウム、イットリウム、ランタン、セリウム、プラセオジウム、ネオジウム、プロメチウム、サマリウム、ユーロピウム、ガドリニウム、テルビウム、ジスプロシウム、ホルミウム、エルビウム、ツリウム、イッテルビウム及びルテチウムからなる希土類元素群から選択される1種類又は2種類以上の組合せである。また、Oは酸素原子を、Sは硫黄原子を示す。さらに、発光中心として機能する物質Mは、Eu、Ceなどの上述の希土類元素や、Mnなどの遷移金属元素、又は、これらの元素を含む化合物である。

【0024】

母材の各構成元素のモル比を表すx、y、z、wは、 $0 < x < 5$ 、 $0 < y < 4$ 、 $0 < z < 8$ 、 $0 < w < 8$ であり、zとwとが同時に0になることはない。

10

【0025】

発光中心として機能する物質Mとしては、例えば、MnやMn化合物、EuやEu化合物、CeやCe化合物が挙げられる。

【0026】

Mn化合物としては、硫化マンガン、酸化マンガン、塩化マンガン、フッ化マンガン等が挙げられる。

【0027】

Eu化合物としては、硫化ユーロピウム、酸化ユーロピウム、塩化ユーロピウム、フッ化ユーロピウム等が挙げられる。

【0028】

Ce化合物としては、硫化セリウム、酸化セリウム、塩化セリウム、フッ化セリウム等が挙げられる。

20

【0029】

このような構成の蛍光体薄膜は、電界が与えられると従来に比して高輝度に発光する。

【0030】

母材の各構成元素のモル比を表すx、y、z、wのより好適な範囲は、各々、 $0 < x < 1.5$ 、 $0 < y < 1.5$ 、 $0 < z < 2.5$ 、 $0 < w < 4.5$ である。

【0031】

また、上記母材において、OまたはSのいずれかが存在していればよいが、母材はSを有する硫化物であることが好ましく、さらに、その場合Sの一部がOに置換されている、すなわち、S及びOを両方含む事がより好ましい。O(酸素原子)は、蛍光体薄膜の寿命を向上させる。母材中のOの量は、 $0.001 < z / (z + w) < 0.6$ の範囲が良く、これにより、寿命を長くできる効果が著しい。

30

【0032】

蛍光体薄膜の組成は、蛍光X線分析(XRF)、X線光電子分析(XPS)、TEM-EDS(Transmission Electron Microscopy - Energy Dispersive X-ray Spectroscopy)等により確認することができる。

【0033】

母材の元素Aとして、好ましいのものは、Sr、Caである。

【0034】

また、母材の元素Bとして、好ましいのものは、Y、La、Gd等である。

40

【0035】

本発明において、赤色に発光する蛍光体薄膜を得るには、元素AをMg、CaあるいはSrから1種類以上選択し、発光中心として機能する物質MとしてEuやEu化合物あるいはMnやMn化合物を用いることが好ましい。また、元素Aとして、Mg、CaあるいはSrから1種類以上選択し、さらに、BaやZnを加えてもよい。また、物質Mの上記元素Aに対する含有量は0.1~10原子%になるようにすることが好ましい。

【0036】

特に、元素AとしてCaを含むと、輝度が高くなる事に加えて、好適な赤の色純度の発光となり、さらに、応答速度が高くなる。元素AとしてCaを含む蛍光体薄膜としては、

50

$Ca_x Y_y O_w S_z : Eu$ が特に好ましい。中でも、 $CaY_2 S_4 : Eu$ がきわめて好ましく、極めて良好な赤色の発光が得られる。

【0037】

また、元素AとしてSrを含む蛍光体薄膜としては、 $Sr_x Y_y O_w S_z : Eu$ 、 $Sr_x Y_y O_w S_z : Mn$ が好ましく、例えば、 $SrY_2 S_4 : Eu$ 、 $SrY_2 S_4 : Mn$ が挙げられる。中でも、 $Sr_x Y_y O_w S_z : Eu$ 、特に $SrY_2 S_4 : Eu$ は、極めて良好な赤色の発光が得られる。

【0038】

また、元素AとしてMgを含む蛍光体薄膜としては、 $Mg_x Y_y O_w S_z : Mn$ が好ましく、例えば、 $MgY_2 S_4 : Mn$ が挙げられる。

10

【0039】

緑色に発光する蛍光体を得るには、元素AをZnとし、発光中心として機能する物質MとしてMnやMn化合物を用いることが好ましい。元素Aとして、Znに対して、さらにMg、Ca、SrあるいはBaから選択された1種類以上の元素を加えたものを用いてもよい。また、物質Mの上記Aに対する含有量は0.1~10原子%になるようにすることが好ましい。元素AとしてZnを含む蛍光体薄膜としては、 $Zn_x Y_y O_w S_z : Eu$ が好ましく、中でも $ZnY_2 S_4 : Eu$ が輝度及び緑の色純度が特に好ましい。このような蛍光体薄膜は、極めて良好な緑色の発光が得られる。

【0040】

青色に発光する蛍光体を得るには、元素AをBaとし、発光中心として機能する物質MとしてMnやMn化合物を用いることが好ましい。元素Aとして、Baに対して、さらにMg、Ca、SrあるいはZnから選択された1種類以上の元素を加えてもよい。また、物質Mの上記Aに対する含有量は0.1~10原子%になるようにすることが好ましい。元素AとしてBaを含む蛍光体薄膜としては、 $Ba_x Y_y O_w S_z : Mn$ が好ましく、中でも、 $BaY_2 S_4 : Mn$ は、輝度及び青の色純度が特に好ましい。上記蛍光体薄膜は、極めて良好な青色の発光を得ることが可能である。

20

【0041】

このような材料を用いた蛍光体薄膜の膜厚としては、50nm~700nmが好ましく、100nm~300nmがより好ましい。蛍光体薄膜が厚すぎると駆動電圧が上昇し、薄すぎると逆に発光効率が低下する。特にこの範囲にすることにより輝度、発光効率共に優れた蛍光体薄膜、特にELパネルが得られる。

30

【0042】

本発明の蛍光体薄膜は通常結晶状態で存在するが、非晶質状態であってもよい。

【0043】

このような蛍光体薄膜を得るには、例えば、スパッタ法や蒸着法等の方法を適応でき、特に以下の蒸着法によることが好ましい。ここでは、 $Ca_1 Y_2 S_4 : Eu$ の組成の蛍光体薄膜を例に説明する。

【0044】

まず、硫化カルシウム粉末、硫化イットリウム粉末および硫化ユーロピウム粉末を混合したものを加圧成型した後、アルゴンガスあるいは硫化水素を含むアルゴンガス中で焼き固めて単一のペレット(蒸発源)を得る。そして、電子ビーム蒸発法、すなわち、このペレットに電子ビームを照射してペレットを蒸発させることにより基板上に蛍光体薄膜を形成する。また、硫化イットリウムと硫化ユーロピウムの代わりに、ブラウン管用などで広く用いられている $Y_2 O_3 : Eu$ 蛍光体粉末や $Y_2 O_2 S : Eu$ 蛍光体粉末を用いてペレットを形成すると硫黄の一部を酸素に置き換えた $Ca_1 Y_2 O_p S_{4-p} : Eu$ の蛍光体薄膜を容易に得ることができる。

40

【0045】

電子ビーム蒸着装置の真空槽には、 $H_2 S$ ガスを導入することが好ましい。ここで $H_2 S$ ガスは、作製される蛍光体薄膜のイオウ不足を避けるためや、イオウを蒸発物質と反応させるために用いている。

50

【0046】

このようにして、 $\text{Ca}_1\text{Y}_2\text{S}_4:\text{Eu}$ の蛍光体薄膜を得た後、窒素中、 Ar 中、真空中などの還元雰囲気、酸素中または空気中などの酸化雰囲気、蛍光体薄膜のアニール処理を行うことが好ましい。アニールの条件としては、好ましくは500 ~ 1000、特に600 ~ 800の範囲の温度で行うとよい。酸化雰囲気中でのアニールは、前述のSをOで置換した蛍光体薄膜の組成を合成するとき有効である。これにより、蛍光体薄膜中のSの一部がOに置換される。

【0047】

発光中心として機能させるべく母材に添加するEuは、硫化物ではなく、金属、フッ化物または酸化物の形でペレット中に添加してもよい。添加量は、ペレット中の原料や形成される蛍光体薄膜の組成により異なるので、適当な添加量となるように原料の組成を調整する。

【0048】

蒸着中の基板温度は、室温 ~ 600、好ましくは、150 ~ 500とすればよい。基板温度が高すぎると、蛍光体薄膜の表面の凹凸が激しくなり、蛍光体薄膜中にピンホールが発生し、ELパネルに電流リークの問題が発生してくる。また、蛍光体薄膜が褐色に色づいたりもする。このため、上述の温度範囲が好ましい。

【0049】

蒸着時の圧力は好ましくは $1.33 \times 10^{-4} \sim 1.33 \times 10^{-1} \text{ Pa}$ ($1 \times 10^{-6} \sim 1 \times 10^{-3} \text{ Torr}$)である。また H_2S などのガスを導入する際、圧力を調整して $6.65 \times 10^{-3} \sim 6.65 \times 10^{-2} \text{ Pa}$ ($5 \times 10^{-5} \sim 5 \times 10^{-4} \text{ Torr}$)とするとよい。圧力がこれより高くなると、Eガンの動作が不安定となり、組成制御が極めて困難になってくる。ガスの導入量としては、真空系の能力にもよるが5 ~ 200 SCCM、特に10 ~ 30 SCCMが好ましい。

【0050】

また、必要により蒸着時に基板を移動、または回転させてもよい。基板を移動、回転させることにより、蛍光体薄膜の組成が均一となり、膜厚分布のバラツキが少なくなる。

【0051】

基板を回転させる場合、基板の回転数としては、好ましくは10回/min以上、より好ましくは10 ~ 50回/min、特に好ましいのが10 ~ 30回/min程度である。基板の回転数が速すぎると、真空チャンバーのシール性が低下する傾向がある。また、基板の回転数が遅すぎると蛍光体薄膜の膜厚方向に組成ムラが生じたり膜厚が不均一となったりして、作製した蛍光体薄膜の特性が低下してくる。基板を回転させる回転手段としては、モータ、油圧回転機構等の動力源と、ギア、ベルト、プーリー等を組み合わせた動力伝達機構・減速機構等を用いた公知の回転機構により構成することができる。

【0052】

ペレットや基板を加熱する加熱手段は所定の熱容量、反応性等を備えたものであればよく、例えばタンタル線ヒータ、シースヒータ、カーボンヒータ等が挙げられる。加熱手段による加熱温度は、好ましくは100 ~ 1400程度、温度制御の精度は、1000で ± 1 が好ましく、 ± 0.5 程度がより好ましい。

【0053】

形成された $\text{Ca}_1\text{Y}_2\text{S}_4:\text{Eu}$ 等の蛍光体薄膜は、高結晶性の薄膜であることが好ましい。結晶性の評価は、例えばX線回折により行うことができる。結晶性をあげるためには、できるだけ蛍光体薄膜の成膜中の基板温度を高温にすることが好ましい。また、薄膜形成後に、真空中、 N_2 中、 Ar 中、S蒸気中、 H_2S 中などで蛍光体薄膜をアニールすることも結晶性をあげるためには効果的である。特に、上述の方法により、硫化物である蛍光体薄膜を得、その後酸化雰囲気中でのこの蛍光体薄膜をアニール処理をすることにより、高輝度に発光しかつ寿命の長い蛍光体薄膜が得られる。

【0054】

本発明の発光層としての蛍光体薄膜を形成するための装置の構成例の一つを図1に示す

10

20

30

40

50

。ここでは、硫化バリウムと硫化イットリウムとを含み、さらに発光中心として機能する物質としてのEuが添加された混合ペレットを蒸発源とし、H₂Sを導入しつつ、蛍光体薄膜を作製する方法を例にとる。図1において、真空層11内には、発光層としての蛍光体薄膜が形成される基板12と、EB蒸発源14が配置されている。

【0055】

EB蒸発源14は、発光中心として機能する物質が添加されたペレット14aが収納される”るつぼ”40と、電子放出用のフィラメント41aを内蔵した電子銃41とを有する。

【0056】

なお、図示例では、説明を容易にするために蒸発源14の配置が基板に対して偏在しているようにもみえるが、実際には蒸着される蛍光体薄膜の組成および膜厚が均一となるような位置に配置される。

【0057】

真空槽11は、排気ポート11aを有し、この排気ポート11aからの排気により、真空槽11内を所定の真空度にできるようになっている。また、この真空槽11は、硫化水素などのガスを導入する原料ガス導入ポート11bを有している。

【0058】

基板12は基板ホルダー12aに固定され、この基板ホルダー12aの固定軸12bは図示しない回転軸固定手段により、真空槽11内の真空度を維持しつつ、外部から回転自在に固定されている。そして、図示しない回転手段により、必要に応じて所定の回転数で基板12を回転可能なようになっている。また、基板ホルダー12aには、ヒーター線などにより構成される加熱手段13が密着・固定されていて、基板12を所望の温度に加熱、保持できるようになっている。

【0059】

このような装置を用い、EB蒸発源14から蒸発させた材料を基板12上に堆積結合させ、Eu添加カルシウムイットレート等の蛍光体薄膜が形成される。そのとき、必要により基板12を回転させることにより、堆積される蛍光体薄膜の組成と膜厚分布をより均一なものとすることができる。

【0060】

本発明の蛍光体薄膜を用いて無機ELパネルを得るには、例えば、図2に示すような構造とすればよい。

【0061】

図2は、本発明の蛍光体薄膜を用いた無機ELパネルの構造の一例を示す一部断面図である。図2において、基板1上にはストライプ状パターン下部電極5が形成されていて、この下部電極5上に誘電体である下部絶縁層2が形成されている。また、この下部絶縁層2上には、発光層としての蛍光体薄膜3、誘電体である薄膜絶縁層4が順次形成されている。薄膜絶縁層4上には、前記下部電極5とマトリクス回路を構成すべく、下部電極5と交差する方向のストライプ状パターンを有する上部電極6が形成されている。

【0062】

下部絶縁層2は、厚膜の誘電体である厚膜絶縁層2aと、この厚膜絶縁層2aの表面を平坦化するための平坦化層として、ゾルゲル法やMOD法など溶液塗布焼成法により形成された絶縁層2bと、を備えている。なお、下部絶縁層2において絶縁層2bがなくても動作は可能である。この場合、厚膜絶縁層2aを平坦化をすべく、厚膜絶縁層2aの表面が研磨されていることが好ましい。

【0063】

また、基板1、下部電極5、上部電極6、厚膜絶縁層2a、絶縁層2b、薄膜絶縁層4のそれぞれの間には、密着性を上げるための層、応力を緩和するための層、反応を防止するバリア層、などの中間層を設けてもよい。

【0064】

ここで、特に絶縁層2bと蛍光体薄膜3の間にバリア層としてBaTiO₃薄膜層を設

けることが好ましい。また、場合により基板 1、下部電極 5、上部電極 6、厚膜絶縁層 2 a、絶縁層 2 b、薄膜絶縁層 4 のそれぞれの間に $B a T i O_3$ 薄膜層を形成しても良い。

【0065】

また、さらに、蛍光体薄膜 3 を $Z n S$ 薄膜でサンドイッチすることが好ましく、これにより、蛍光体薄膜の電荷の注入特性、耐電圧特性が向上し、より高輝度な E L 素子を得ることができる。 $Z n S$ 薄膜の膜厚は、 $30 \text{ nm} \sim 400 \text{ nm}$ が好ましく、 $100 \sim 300 \text{ nm}$ がより好ましい。

【0066】

すなわち、E L パネルは、 $Z n S$ 薄膜 / 蛍光体薄膜 / $Z n S$ 薄膜の構造であることが好ましい。また、E L パネルは、 $Z n S$ 薄膜 / 蛍光体薄膜 / $Z n S$ 薄膜 / . . . / 蛍光体薄膜 / $Z n S$ 薄膜のように、 $Z n S$ 薄膜と蛍光体薄膜とを交互に積層し、かつ、最外層を $Z n S$ 薄膜とするような構造であってもよい。

10

【0067】

また、無機 E L パネルの構造は、厚膜絶縁層 2 a を有さず、蛍光体薄膜 3 を、例えば、タンタル酸バリウムなどの一对の薄膜誘電体で挟んだ積層構造の両端に薄膜状の電極を形成したものでよい。

【0068】

基板として用いる材料は、厚膜絶縁層 2 a の形成温度、絶縁層 2 b や薄膜絶縁層 4 の形成温度、および蛍光体薄膜 3 の形成温度、蛍光体薄膜 3 のアニール温度に耐えうる耐熱温度以上のものであり、所定の強度を維持できるものであれば特に限定されるものではない。厚膜絶縁層 2 a を用いる場合には、融点が 600 以上、好ましくは 700 以上、特に 800 以上の耐熱温度を有する基板を用いる。具体的には、ガラス基板やアルミナ ($A l_2 O_3$)、フォルステライト ($2 M g O \cdot S i O_2$)、ステアタイト ($M g O \cdot S i O_2$)、ムライト ($3 A l_2 O_3 \cdot 2 S i O_2$)、ベリリア ($B e O$)、窒化アルミニウム ($A l N$)、窒化シリコン ($S i N$)、炭化シリコン ($S i C + B e O$) 等のセラミック基板、結晶化ガラスなど耐熱性ガラス基板を挙げることができる。これらのなかでも特にアルミナ基板、結晶化ガラスが好ましく、熱伝導性が必要な場合にはベリリア、窒化アルミニウム、炭化シリコン等が好ましい。

20

【0069】

また、このほかに、石英、熱酸化シリコンウエハー等、チタン、ステンレス、インコネル、鉄系などの金属基板を用いることもできる。金属等の導電性基板を用いる場合には、基板上に内部に電極を有した厚膜を形成した構造が好ましい。

30

【0070】

厚膜絶縁層 2 a の材料としては、公知の厚膜誘電体材料を用いることができる。さらに比較的誘電率の大きな材料が好ましい。

【0071】

例えばチタン酸鉛系、ニオブ酸鉛系、チタン酸バリウム系等の材料を用いることができる。

【0072】

厚膜絶縁層 2 a の抵抗率としては、 $10^8 \cdot \text{cm}$ 以上、特に、 $10^{10} \sim 10^{18} \cdot \text{cm}$ 程度が好ましい。また比較的高い誘電率を有する物質であることが好ましく、その誘電率としては、好ましくは $= 100 \sim 10000$ 程度である。厚膜絶縁層 2 a の膜厚としては、 $5 \sim 50 \mu\text{m}$ が好ましく、 $10 \sim 30 \mu\text{m}$ が特に好ましい。

40

【0073】

厚膜絶縁層 2 a の形成方法は、特に限定されず、 $10 \sim 50 \mu\text{m}$ 厚の膜が比較的容易に得られる方法が良いが、ゾルゲル法、印刷焼成法などが好ましい。

【0074】

印刷焼成法による場合には、まず、材料の粒度を適当に揃え、バインダーと混合し、適当な粘度のペーストとする。つづいて、このペーストを基板上にスクリーン印刷法により形成し、乾燥させる。その後、このグリーンシートを適当な温度で焼成し、厚膜絶縁層 2

50

aを得る。

【0075】

薄膜絶縁層4の構成材料としては、例えばタンタル酸バリウム($BaTa_2O_6$)、酸化シリコン(SiO_2)、窒化シリコン(SiN)、酸化タンタル(Ta_2O_5)、チタン酸ストロンチウム($SrTiO_3$)、酸化イットリウム(Y_2O_3)、チタン酸バリウム($BaTiO_3$)、チタン酸鉛($PbTiO_3$)、PZT、ジルコニア(ZrO_2)、シリコンオキシナイトライド($SiON$)、アルミナ(Al_2O_3)、ニオブ酸鉛、PMN-PT系材料等およびこれらの多層または混合薄膜を挙げることができ、これらの材料で薄膜絶縁層4を形成する方法としては、蒸着法、スパッタ法、CVD法、ゾルゲル法、印刷焼成法など既存の方法を用いればよい。この場合の薄膜絶縁層4の膜厚としては、好ましくは50~1000nm、特に100~500nm程度である。 10

【0076】

下部電極5は、少なくとも基板1上または厚膜絶縁層2a内に形成される。厚膜絶縁層2aの形成時や、さらに蛍光体薄膜の熱処理時に高温下にさらされる下部電極5は、主成分としてパラジウム、ロジウム、イリジウム、レニウム、ルテニウム、白金、タンタル、ニッケル、クロム、チタン等の1種または2種以上の金属を含む通常用いられている金属電極を用いればよい。厚膜絶縁層2aを用いず一对の薄膜誘電体で蛍光体薄膜3を挟みこんだEL素子の場合、下部電極5にはZnOやITOなどの透明電極を用いることができる。

【0077】

また、上部電極6としては、通常、発光を基板と反対側から取り出すため、所定の発光波長域で透光性を有する透明電極であることが好ましい。なお、基板1および厚膜絶縁層2が透光性を有するものである場合は、発光光を基板1側から取り出すべく、下部電極5を透明電極としてもよい。 20

【0078】

透明電極としては、ZnO、ITOなどを用いることが特に好ましい。ITOは、通常 In_2O_3 と SnO とを化学量論組成で含有するが、O量は多少これから偏倚していてもよい。 In_2O_3 に対する SnO_2 の混合比は、1~20質量%、さらには5~12質量%が好ましい。また、IZOでの In_2O_3 に対するZnOの混合比は、通常、12~32質量%程度である。 30

【0079】

また、これらの電極は、シリコンを有するものでも良い。このシリコン電極層は、多結晶シリコン(p-Si)であっても、アモルファス(a-Si)であってもよく、必要により単結晶シリコンであってもよい。

【0080】

シリコンを有する電極は、主成分のシリコンに加え、導電性を確保するため物質をドーピングする。物質として用いられるドーパントは、所定の導電性を確保しうるものであればよく、シリコン半導体に用いられている通常のドーパントを用いることができる。具体的には、B、P、As、Sb、Al等が挙げられ、これらのなかでも、特にB、P、As、SbおよびAlが好ましい。ドーパントの濃度としては0.001~5原子%程度が好ましい。 40

【0081】

これらの材料で電極層を形成する方法としては、蒸着法、スパッタ法、CVD法、ゾルゲル法、印刷焼成法など既存の方法を用いればよいが、特に、基板1上に内部に下部電極5を有した厚膜絶縁層2aを形成した構造を作製する場合、厚膜絶縁層2aの形成と同じ方法で電極層を形成することが好ましい。

【0082】

上部・下部電極層4、5の好ましい抵抗率としては、発光層3に効率よく電界を付与するため、1・cm以下、特に0.003~0.1・cmが好ましい。これらの電極層の膜厚としては、形成する材料にもよるが、好ましくは50~2000nm、特に100 50

~ 1000 nm 程度が好ましい。

【0083】

以上、 $Ca_1 Y_2 S_4 : Eu$ 蛍光体薄膜を用いた EL パネルについて、説明したが、本発明において元素 A は Ca に限定されるものではなく、Mg、Ca、Sr、Ba および Zn のいずれか 1 種または 2 種以上であればよい。また、元素 B も Y に限定されるものではなく、上述の希土類元素の何れか 1 種または 2 種以上であればよい。

【0084】

ここで、元素 A として、Ca 以外の Mg、Sr、Ba、Zn の元素を用いる場合には、これらの硫化物や酸化物を含むペレットを用いればよい。また、元素 B として、Y 以外の希土類元素を用いる場合も、Y 以外の希土類元素の硫化物、酸化物等を含むペレットを用

10

【0085】

さらに、発光中心として機能する物質も Eu でなく、Eu の化合物でもよく、Ce やその化合物、Mn やその化合物等を用いても良い。この場合も、これらの金属や、金属の酸化物、硫化物等を含むペレットを用いればよい。

【0086】

さらに、母対材料が硫黄を含まない、すなわち、 $z = 0$ の蛍光体薄膜を作製するためには、電子ビーム蒸着装置の真空層内に $H_2 S$ ガスを導入せず、かつ、アニール時にも $H_2 S$ ガスを導入しなければよい。この場合、例えば、 $Ca Y_2 O_4 : Eu$ であれば、CaO、 $Y_2 O_3$ 、 $Eu_2 O_3$ 等を含むペレットによる電子ビーム蒸着や、CaO、 $Y_2 O_3$ の

20

【0087】

そして、このような EL パネルの発光層 3 において、RGB の 3 色に対応する蛍光体薄膜を並設することにより、フルカラー EL パネルが得られる。

【0088】

このような EL パネルは、主にディスプレイ用のフルカラーパネル、マルチカラーパネル、部分的に 3 色を表示するパーシャリーカラーパネルに応用することができる。

【実施例】

【0089】

以下、本発明の具体的実施例を示し、本発明をさらに詳細に説明する。

30

【0090】

〔実施例 1〕

本発明の蛍光体薄膜を用いた EL パネル (EL 素子) を作製した。ガラス基板上に ITO 透明電極を 100 nm スパッタリング法により形成し、この上にタンタル酸バリウム薄膜誘電体をスパッタリング法により 300 nm 形成した。この上に、EL 薄膜 / タンタル酸バリウム薄膜 (200 nm) の構造体を作製した。EL 薄膜は、ZnS 膜 (200 nm) / 蛍光体薄膜 (300 nm) / ZnS 膜 (200 nm) の構造とした。

【0091】

蛍光体薄膜の作製にあたって、以下のような電子ビーム蒸着法を用いた。

【0092】

Eu を 0.5 mol % 添加した $Ca_1 Y_2 S_4$ ペレットを入れた EB 源を $H_2 S$ ガスを導入した真空槽内に設け、この源より所定の蒸発速度でペレットを蒸発させ、400 に加熱し回転させた基板上に蛍光体薄膜を成膜した。蒸発源の蒸発速度は、基板上に成膜される膜の成膜速度が 1 nm / sec になるように調節した。このとき $H_2 S$ ガスを 20 SCCM 導入し、蛍光体薄膜を得た。

40

【0093】

このようにして、BaTa₂O₆ 膜 (200 nm) / ZnS 膜 (200 nm) / 蛍光体薄膜 (400 nm) / ZnS 膜 (200 nm) / BaTa₂O₆ 膜 (300 nm) / 透明電極 (100 nm) / 基板の構造の積層体を得た後、700 のアルゴン中で 10 分間アニールした。

50

【0094】

さらに、得られた積層体上にITO酸化物ターゲットを用いRFマグネトロンスパッタリング法により、基板温度250 で、膜厚200nmのITO透明電極を形成し、ELパネルを完成した。

【0095】

得られたELパネルの2つの電極間に1kHz、パルス幅50 μ Sの電界を印加することにより、400cd/m²、CIE 1931色度図で(0.67, 0.33)のNTSCレベルの赤色発光輝度が再現良く得られた。本ELパネルでは、電圧を印加してから発光が安定するまでの応答時間が、従来例では数秒から数十秒であったものが、20ms以下まで向上していた。図3に発光スペクトルを、図4にL-V特性を示す。従来に較べ、高輝度のELパネルが得られることがわかる。

10

【0096】

ここで、蛍光体薄膜の組成を蛍光X線分析により調べたところ、各元素のモル比は、Ca : Y : S : Eu = 10.36 : 29.24 : 43.49 : 0.57であった。

【0097】

〔比較例1〕

蛍光体薄膜を、従来赤色EL材料として優れていると言われているCaS : Euとする以外は、実施例1と同様にしてELパネルを得た。得られたELパネルの発光輝度は、1kHz駆動で80cd/m²程度であり、かつ、電圧を印加してから発光が安定するまでの応答時間が、数秒から数十秒であり、カラーディスプレイのELパネルとするためには、より高輝度化と応答性の改善が必要であった。発光スペクトルを図3に示す。

20

【0098】

〔実施例2〕

実施例1において、蛍光体薄膜の材料をCa₁Y₂S₄ : Euから種々のイットレート蛍光体に変えることにより各種のELパネルを作製した。具体的には、各イットレート蛍光体をBa₁Y₂S₄ : Eu、Sr₁Y₂S₄ : Eu、Ba₁Y₂S₄ : Mn、Sr₁Y₂S₄ : Mn、Mg₁Y₂S₄ : Mn、Zn₁Y₂S₄ : Mnとした。これらのチオイットレート蛍光体を用いたELパネルの発光ピーク波長とCIE 1931色度値とを表1に示す。ここで、発光ピーク波長及び色度値についてはPL (Photo Luminescence) スペクトルから算出した。各蛍光体薄膜のPLスペクトルの測定結果を図5, 6に示す。

30

【表1】

蛍光体材料	発光ピーク波長(nm)	色度座標
BaY ₂ S ₄ :Eu	592	(0.555,0.440)
SrY ₂ S ₄ :Eu	624	(0.636,0.361)
BaY ₂ S ₄ :Mn	460	(0.172,0.157)
SrY ₂ S ₄ :Mn	650	(0.565,0.373)
MgY ₂ S ₄ :Mn	716	(0.556,0.374)
ZnY ₂ S ₄ :Mn	518	(0.228,0.565)
CaY ₂ S ₄ :Eu	682	(0.612,0.382)

40

これらのELパネルは、いずれも、実施例1と同等程度の高輝度の発光を呈した。中で

50

も、 $Sr_1 Y_2 S_4 : Eu$ の輝度は 700 cd/m^2 と著しく高くなった。

【0099】

また、PLスペクトルの結果から、特に $Sr_1 Y_2 S_4 : Eu$ からきわめて色純度の良い高輝度赤色発光が得られ、 $Ba_1 Y_2 S_4 : Mn$ から高輝度な青色発光が得られたのがわかる。 $Sr_1 Y_2 S_4 : Eu$ の電圧 - 輝度特性を図7に示す。

【0100】

さらに、 $Zn Y_2 S_4 : Mn$ からはきわめて色純度の良い緑色の高輝度発光が得られた。

【0101】

なお、実施例1で得られた $Ca_1 Y_2 S_4 : Eu$ のELパネルについてのPLスペクトルも図5に、このPLスペクトルにより得られた実施例1のELパネルの発光ピーク波長及び色度値についても表1に各々示す。

【0102】

これによって、 Ca 、 Ba 、 Sr 、 Mg からなるアルカリ土類金属や Zn と、イットリウムと、を含む複合硫化物に、発光中心として機能する物質を添加した蛍光体薄膜は、従来に比してきわめて高輝度に発光することが確認された。ここで、イットリウムに代えて、イットリウムと同様の性質を有する他の希土類金属を添加しても、同様の効果があるものと類推される。

【0103】

〔実施例3〕

実施例1において、蛍光体薄膜の材料を $Ca_1 Y_2 S_4 : Eu$ から $Ca_1 Y_2 O_2 S_2 : Eu$ 蛍光体に代えたELパネルを作製した。

【0104】

具体的には、 CaS 、 $Y_2 S_3$ 、 $Y_2 O_3$ 、 $Eu_2 S_3$ を含むターゲットを用いて蒸着法により形成した。図8に、ELパネルの発光スペクトルを示す。この蛍光体も、実施例1と同様の輝度及び応答性を示した。

【0105】

〔実施例4〕

実施例1の蛍光体薄膜を用いて厚膜絶縁層を有するELパネル(EL素子)を作製した。基板、厚膜絶縁層とも同じ材料である $BaTiO_3$ 系の誘電体材料(誘電率 : 5000)を用い、下部電極としてPd電極を用いた。

【0106】

まず、基板のシートを作製し、この上に下部電極、厚膜絶縁層をスクリーン印刷してグリーンシートとし、同時に焼成した。得られた複合基板の表面を研磨し、 $30 \mu\text{m}$ 厚の厚膜絶縁層付き基板を得た。さらに、この上にバリア層として $BaTiO_3$ 膜をスパッタリング法により膜厚 400 nm に形成し、 700°C の空气中でアニールし、複合基板とした。

【0107】

この複合基板上に、ELパネルとして安定に発光させるため、 $Al_2 O_3$ 膜(50 nm) / EL薄膜 / $Al_2 O_3$ 膜(50 nm)の構造体を作製した。EL薄膜は、 ZnS 膜(200 nm) / 蛍光体薄膜(300 nm) / ZnS 膜(200 nm)の構造とした。

【0108】

蛍光体薄膜の作製にあたって、実施例1と同様に $Ca_1 Y_2 S_4 : Eu$ 薄膜を作製して用いた。

【0109】

得られた積層薄膜は、 $Al_2 O_3$ 膜(50 nm) / ZnS 膜(200 nm) / 蛍光体薄膜(300 nm) / ZnS 膜(200 nm) / $Al_2 O_3$ 膜(50 nm)の構造にしてから、 700°C の空气中で10分間アニールした。

【0110】

さらに、得られた積層薄膜上にITO酸化物ターゲットを用いRFマグネトロンスパッタ

タリング法により、基板温度 250 で、膜厚 200 nm の ITO 透明電極を形成し、EL パネルを完成した。

【0111】

得られた EL パネルの 2 つの電極間に 1 kHz、パルス幅 50 μ S の電界を印加することにより、500 cd/m^2 、CIE 1931 色度図で (0.67, 0.33) の赤色発光輝度が得られた。本 EL 素子では、応答性が比較例 1 で、数秒から数十秒であったものが、20 ms 以下まで向上していた。従来 of 赤色材料である CaS:Eu を用いた比較例 1 の EL パネルでは 80 cd/m^2 程度であったものに対して高輝度の EL 素子が得られることがわかる。

【0112】

以上の実施例から明らかなように本発明の蛍光体薄膜を有する EL パネルは、高輝度に発光する。

【0113】

このような蛍光体薄膜を用いた EL パネルを利用することにより、特に、輝度の高い多色 EL パネルやフルカラー EL パネルを実現でき、実用的価値は大きい。

【図面の簡単な説明】

【0114】

【図 1】本実施形態の蛍光体薄膜を用いた無機 EL パネルの構成例を示す一部断面図である。

【図 2】本実施形態の蛍光体薄膜を成膜するための装置の構成例を示す概略断面図である。

【図 3】実施例 1 の一方の EL パネル及び比較例 1 の EL パネルの発光スペクトルを示したグラフである。

【図 4】実施例 1 の一方の EL パネルの L - V 特性を示したグラフである。

【図 5】実施例 2 における発光中心が Eu の EL パネル及び実施例 1 の EL パネルの PL スペクトルを示したグラフである。

【図 6】実施例 2 における発光中心が Mn の EL パネルの PL スペクトルを示したグラフである。

【図 7】実施例 2 の Sr₁Y₂S₄:Eu の EL パネルの電圧 - 輝度特性を示すグラフである。

【図 8】実施例 3 の EL パネルの発光スペクトルを示したグラフである。

【符号の説明】

【0115】

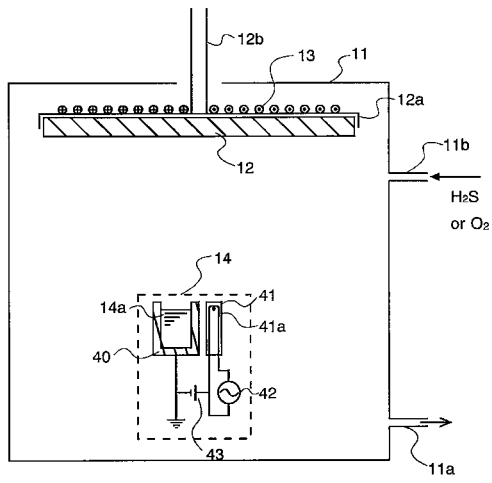
1 ... 基板、2 ... 下部絶縁層、2 a ... 厚膜絶縁体層、2 b ... 溶液塗布焼成法により形成された絶縁層、3 ... 蛍光体薄膜 (発光層)、4 ... 薄膜絶縁体層、5 ... 下部電極、6 ... 上部電極 (透明電極)。

10

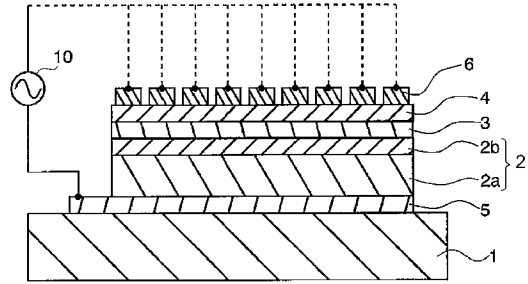
20

30

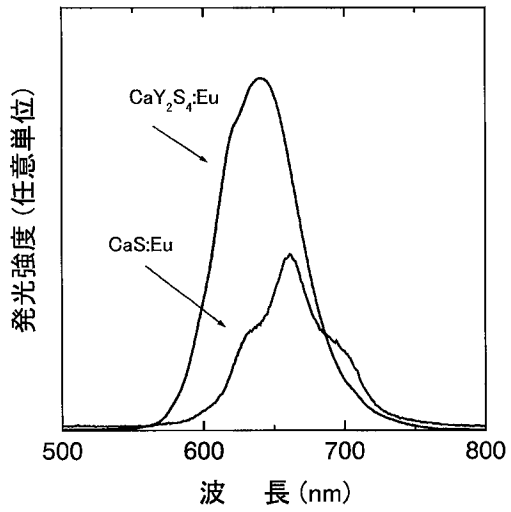
【 図 1 】



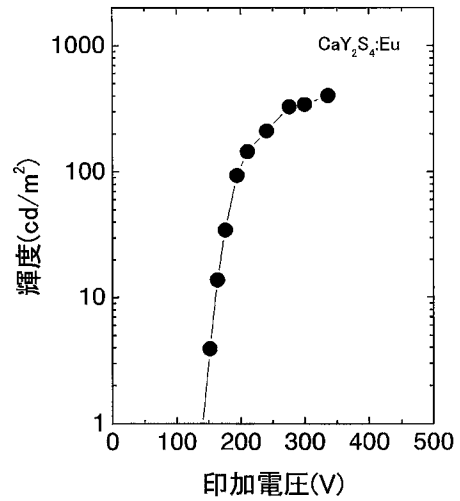
【 図 2 】



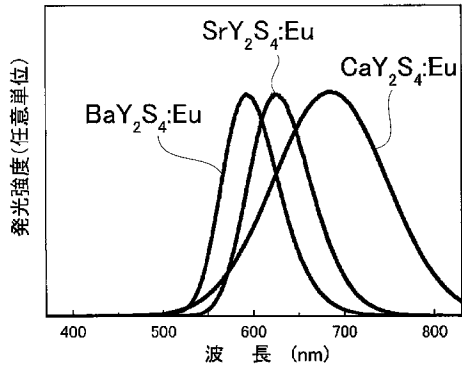
【 図 3 】



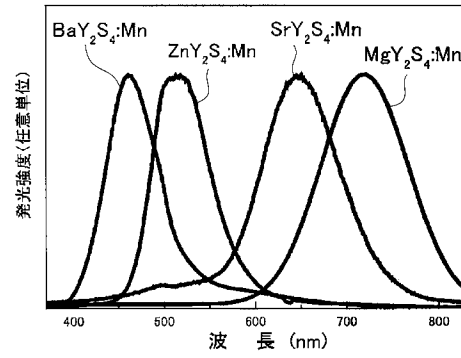
【 図 4 】



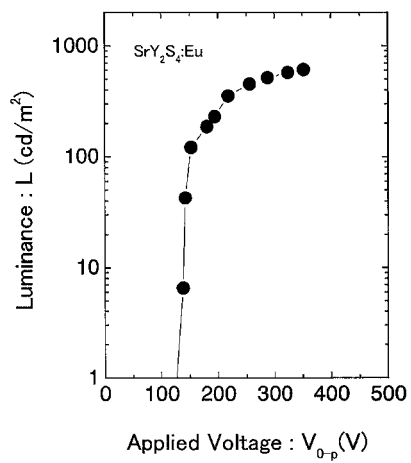
【 図 5 】



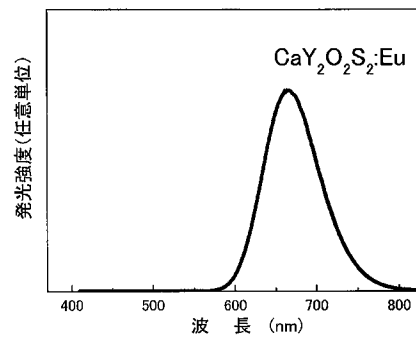
【 図 6 】



【 図 7 】



【 図 8 】



フロントページの続き

(51) Int.Cl. ⁷	F I	テーマコード(参考)
C 2 3 C 14/06	C 0 9 K 11/84	C P C
H 0 5 B 33/10	C 2 3 C 14/06	D
H 0 5 B 33/14	H 0 5 B 33/10	
	H 0 5 B 33/14	Z

(72)発明者 川西 光宏
 神奈川県川崎市多摩区西生田二丁目 1 - 1 5 - 2 0 7

(72)発明者 矢野 義彦
 東京都中央区日本橋一丁目 1 3 番 1 号 T D K 株式会社内

F ターム(参考) 3K007 AB02 AB04 DB01 DB02 DC02 DC04 FA01
 4H001 CA04 CF01 CF02 XA00 XA08 XA12 XA16 XA20 XA21 XA30
 XA38 XA39 XA56 YA25 YA58 YA63
 4K029 AA09 AA24 BA45 BA50 BA51 BB02 BC09 BD00 CA02 CA05
 DB05 DB08 DB21 GA01

专利名称(译)	<无法获取翻译>		
公开(公告)号	JP2004137480A5	公开(公告)日	2005-08-04
申请号	JP2003326736	申请日	2003-09-18
[标]申请(专利权)人(译)	东京电气化学工业株式会社 三浦 登		
申请(专利权)人(译)	TDK株式会社 三浦 登		
[标]发明人	三浦登 川西光宏 矢野義彦		
发明人	三浦 登 川西 光宏 矢野 義彦		
IPC分类号	H05B33/10 B32B9/00 B32B19/00 C09K11/00 C09K11/08 C09K11/77 C09K11/78 C09K11/84 C23C14/06 H05B33/14		
CPC分类号	C09K11/7789 C09K11/7702 C09K11/7703 C09K11/7786 C23C14/06 Y10S428/917		
FI分类号	C09K11/78.CPB C09K11/78.CPD C09K11/00.F C09K11/08.A C09K11/08.B C09K11/84.CPC C23C14/06.D H05B33/10 H05B33/14.Z		
F-TERM分类号	3K007/AB02 3K007/AB04 3K007/DB01 3K007/DB02 3K007/DC02 3K007/DC04 3K007/FA01 4H001/CA04 4H001/CF01 4H001/CF02 4H001/XA00 4H001/XA08 4H001/XA12 4H001/XA16 4H001/XA20 4H001/XA21 4H001/XA30 4H001/XA38 4H001/XA39 4H001/XA56 4H001/YA25 4H001/YA58 4H001/YA63 4K029/AA09 4K029/AA24 4K029/BA45 4K029/BA50 4K029/BA51 4K029/BB02 4K029/BC09 4K029/BD00 4K029/CA02 4K029/CA05 4K029/DB05 4K029/DB08 4K029/DB21 4K029/GA01 3K107/AA07 3K107/BB01 3K107/CC02 3K107/DD55 3K107/DD56 3K107/FF14 4H001/XA90		
代理人(译)	长谷川良树 阿部丰高		
优先权	2002274516 2002-09-20 JP		
其他公开文献	JP2004137480A		

摘要(译)

解决的问题：提供高亮度的磷光体薄膜，其制造方法以及使用该薄膜的EL面板。磷光体薄膜由组成公式 $A_x B_y O_w S_z$ 表示。以及作为基材的发光中心的物质。（上述组成式中的A为选自Mg, Ca, Sr, Ba和Zn中的至少一种元素，B为Sc, Y, La, Ce, Pr, Nd, Pm, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb以及选自Lu的至少一种元素，O表示氧原子，S表示硫原子，且 $0 < x < 5$ 、 $0 < y < 4$ 、 $0 \leq z < 8$ 、 $0 \leq w < 8$ ，且 $0 = z = w$ 不成立。）荧光体薄膜是上述元素的硫化物或氧化物，并用作发光中心。它是通过气相沉积法从功能性物质形成薄膜并对其进行退火而制造的，并用于EL面板。[选择图]无